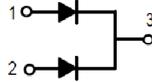


Super Fast Recovery Diode, 200A

Features

- Dual Diode Construction
- Low Leakage Current
- Low forward voltage drop
- High surge current capability
- Super Fast Switching



TWIN TOWER PACKAGE

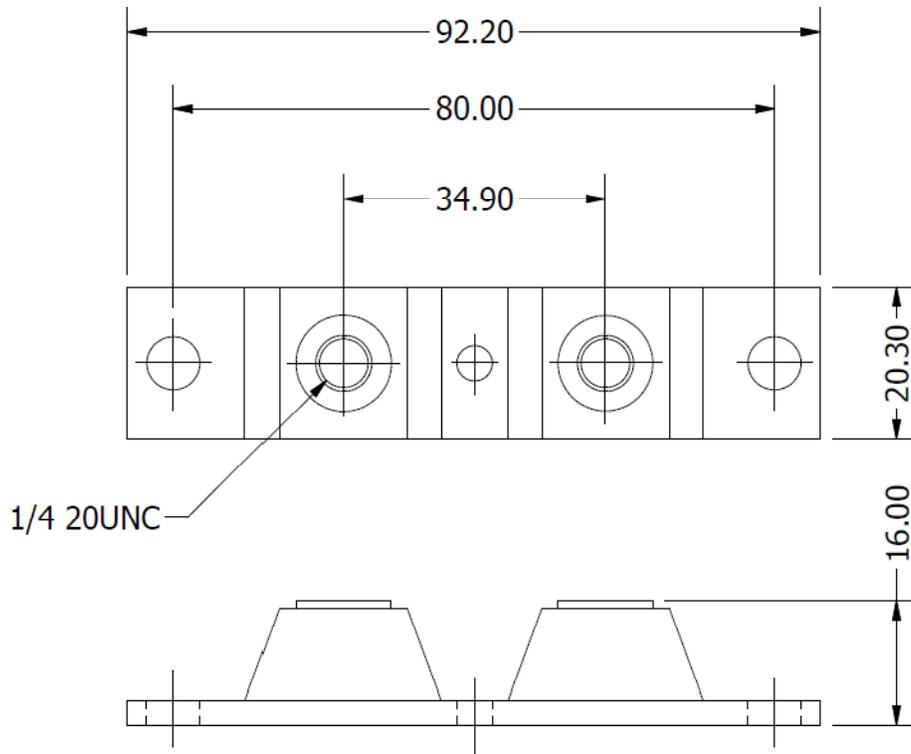
| Maximum Ratings ($T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified) | | | | | |
|--|-------------|------------------------------|---------------|---------------|-------|
| Parameter | Symbol | Conditions | MUR20040CT(R) | MUR20060CT(R) | Units |
| Repetitive peak reverse voltage | V_{RRM} | | 400 | 600 | V |
| RMS reverse voltage | V_{RMS} | | 280 | 420 | V |
| DC blocking voltage | V_{DC} | | 400 | 600 | V |
| Average forward current | $I_{F(AV)}$ | $T_C \leq 140^\circ\text{C}$ | 200 | 200 | A |
| Non-repetitive forward surge current, half sine-wave | I_{FSM} | $T_C = 25^\circ\text{C}$ | 800 | 800 | A |

| Electrical Characteristics ($T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified) | | | | | |
|---|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| Parameter | Symbol | Conditions | MUR20040CT(R) | MUR20060CT(R) | Units |
| DC forward voltage | V_F | $I_F = 50\text{ A}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$ | 1.3 | 1.7 | V |
| DC reverse current | I_R | $V_R = 50\text{ V}$ $T_J = 25^\circ\text{C}$ | 25 | 25 | μA |
| | | $V_R = 50\text{ V}$ $T_J = 125^\circ\text{C}$ | 1 | 1 | mA |
| Maximum Reverse Recovery Time | t_{rr} | $I_F = 0.5\text{ A}$ $I_R = 1.0\text{ A}$ $I_{RR} = 0.25\text{ A}$ | 90 | 110 | nS |

| Thermal Characteristics ($T_J = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified) | | | | | |
|--|----------------|--|---------------|---------------|---------------------------|
| Parameter | Symbol | | MUR20040CT(R) | MUR20060CT(R) | Units |
| Thermal resistance junction to case | R_{thj-c} | | 1.0 | 1.0 | $^\circ\text{C}/\text{W}$ |
| Operating, storage temperature range | T_J, T_{stg} | | - 40 to +175 | - 40 to +175 | $^\circ\text{C}$ |



Package Outline



ALL DIMENSIONS IN MM

Ordering Table

| MUR | 200 | 40 | CT |
|-----|-----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

- 1 – Device Type
 - > MUR = Dual Diode Recovery Module
- 2 – Current Rating = $I_{F(AV)}$
- 3 – Voltage = code x 10 = V_{RRM}
- 4 – Polarity
 - > CT = Normal (Cathode to Base)
 - > CTR = Reverse (Anode to Base)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.